

КИНЕТИКА ДЕЛЕНИЯ ЯЧЕЕК В ЯЧЕИСТОЙ ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ

Г. А. Малыгин

В процессе пластической деформации дислокационная структура в кристаллах, особенно металлических, как правило, не остается однородной, а приобретает характерное ячеистое строение [1-4]. Как установлено в [1], в первый момент после возникновения такой структуры существует довольно широкое распределение ячеек по размерам — от некоторого минимального размера Λ_1 до максимального Λ_2 . В ходе дальнейшей деформации ячейки больших размеров измельчаются путем образования внутри них новых дислокационных границ [1-3]. Процесс деления ячеек продолжается до тех пор, пока не будет достигнут некоторый равновесный размер ячеек Λ_∞ , близкий к Λ_1 . В результате деления ячеек средний их размер уменьшается с деформацией (рис. 1).

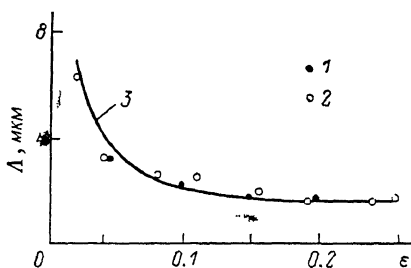


Рис. 1. Зависимость размера ячеек в Al при 293 К от величины пластической деформации.

1 — [2], 2 — [3], 3 — согласно (4).

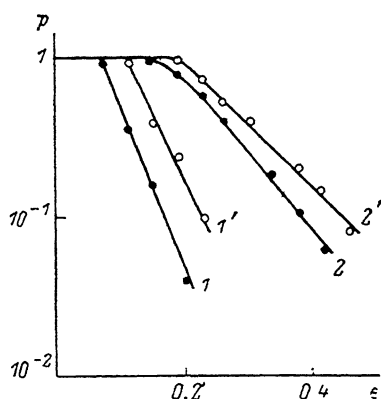


Рис. 2. Зависимость от деформации относительной доли объема сплава Ni₃Fe при 293 К, не занятой еще неразориентированной (1, 1') и разориентированной (2, 2') ячеистыми структурами.

1, 2 — размер зерна 40; 1', 2' — 450 мкм [4].

Целью настоящей работы является теоретический анализ кинетики этого деления. В литературе этот вопрос не был до сих пор предметом специального теоретического обсуждения.

Для формирования новых дислокационных границ требуются, очевидно, свежие дислокации. Следовательно, кинетика размножения границ должна быть связана с кинетикой размножения дислокаций. В [5] было сформулировано уравнение эволюции неоднородной плотности дислокаций ρ на второй и третьей стадиях кривых деформационного упрочнения кристаллов, в пределах которых формируется и эволюционирует ячеистая структура

$$\frac{\partial \rho}{\partial \gamma} + (\xi - 1) \frac{\lambda_D}{b\rho} \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} = \chi_m - \chi_i + \chi_f \rho^{1/2} - \chi_a \rho. \quad (1)$$

Здесь γ — деформация, x — пространственная координата, b — вектор Бюргерса. Уравнение (1) включает в себя процессы размножения (коэффициенты χ_m и χ_f [5, 6]), иммобилизации (χ_i [5]), аннигиляции (χ_a [6, 7]) и диффузии (λ_D , ξ [8]) дислокаций в деформируемом кристалле. Анализ стационарных ($\partial \rho / \partial \gamma = 0$) решений этого уравнения показал [5], что при

выполнении определенных условий оно описывает пространственно-перIODическую дислокационную структуру с равновесным размером ячеек Λ_∞ . В настоящей работе мы используем это уравнение для анализа кинетики деления ячеек, привлекая дополнительно для этой цели вытекающий из эксперимента принцип подобия дислокационных структур при различных степенях пластической деформации [1].

Согласно этому принципу, плотность дислокаций в границах дислокационных ячеек ρ_r изменяется с деформацией по тому же закону, что и полная плотность дислокаций ρ , $\rho_r(\gamma) = \delta_r \rho(\gamma)$, где $\delta_r > 1$ — коэффициент подобия. Так как плотность границ на единицу длины $N = \Lambda^{-1}$, где Λ — текущий размер ячеек, а дислокации сосредоточены в основном в их границах, то полная плотность дислокаций $\rho = \Lambda^{-1} h^{-1}$, где $h = \rho_r^{-1/2} = \delta_r^{-1/2}$ — расстояние между дислокациями в границах,¹ $\delta = \delta_r^{1/2}$. Таким образом, имеем $N = \Lambda^{-1} = \delta \rho^{1/2}(\gamma)$. Это означает, что эволюция N и Λ с деформацией определяется эволюцией ρ с γ , т. е. уравнением типа (1).

Подставляя в (1) $N = \Lambda^{-1} \sim \rho^{1/2}$ и предполагая, что процесс размножения границ и деления ячеек происходит квазигомогенно, получаем для безразмерных плотности границ $n = N/N_1$ и размера ячеек $\lambda = \Lambda/\Lambda_1$ уравнения

$$\frac{dn}{d\gamma} = \frac{1}{2} z_a \left(1 - \frac{\psi_1}{n}\right) (1 - n), \quad \frac{\partial \lambda}{\partial \gamma} = \frac{1}{2} z_a \lambda (1 - \psi_0 \lambda) (\lambda - 1), \quad (2)$$

где

$$N_1 = \Lambda_1^{-1} = \delta \rho_1^{1/2}, \\ \psi_0 = \frac{\rho_2^{1/2}}{\rho_1^{1/2}}, \quad \psi_1 = z = \left(\frac{x_f}{2x_a}\right) (1 \pm \sqrt{1 - \eta}), \quad \eta = \frac{4z_a}{z_f^2} (z_i - z_m). \quad (3)$$

Из уравнений (2) следует, что процесс размножения границ и деления ячеек начинается при $n > \psi_0$ или с учетом обозначений (3) при критическом расстоянии между границами $\Lambda_2 = 1/(\delta \rho_1^{1/2})$ и заканчивается при $n = 1$, т. е. при $\Lambda_1 = 1/(\delta \rho_1^{1/2})$. Например, в меди [1] $\Lambda_1/\Lambda_2 = \psi_0 \approx 0.17$.

По своему содержанию первое из уравнений (2) является типичным уравнением, описывающим кинетику фазового превращения [9], где n имеет смысл относительного объема материала, занятого новой фазой. В рассматриваемом случае новой «фазой» являются области кристалла с высокой плотностью дислокаций (дислокационные стенки). Поскольку для устойчивого роста «фазы» требуется некоторая критическая ее концентрация $n_k = \psi_0$, зависимость $n(\gamma)$ имеет сигмоидальный вид. Интегрируя (2) при $n \gg \psi_0$ и $\lambda \ll \psi_0^{-1}$, получаем (полагая $\Lambda_1 = \Lambda_\infty$)

$$\Lambda = \Lambda_\infty / (1 - e^{-\gamma a \Gamma^2}), \quad n \approx 1 - e^{-z_a \gamma^2}. \quad (4)$$

Сплошная кривая на рис. 1 проведена в соответствии с первым выражением (4); $\gamma = t\epsilon$, где t — ориентационный фактор. При относительно небольших деформациях $\gamma \ll 2/x_a$ размер ячеек $\Lambda \sim 1/\gamma$, а при больших стремится к равновесному значению Λ_∞ [5].

Из второго соотношения (4) следует, что доля объема материала, свободного от дислокационных границ, $p = 1 - n$ должна экспоненциально убывать с деформацией. На рис. 2 приведены результаты анализа [4] дислокационной структуры в упорядоченном сплаве Ni_3Fe (прямые 1, 1'), подтверждающие это экспоненциальное убывание. Видно, что для возникновения ячеистой структуры в этом сплаве требуется некоторая критическая величина деформации, тем большая, чем больше размер зерен. Интересно отметить, что и в случае разориентированной ячеистой структуры доля объема материала, еще не занятого ею, также экспоненциально снижается с ϵ (кривые 2, 2').

¹ Границы ячеек имеют конечную ширину $\Delta \Lambda \gg b$ [1, 5], т. е. представляют из себя двумерные, а не одномерные, как в случае полигонизованных границ наклona, образования. Они содержат дислокации разного знака, среднее расстояние между которыми $h = \rho_r^{-1/2}$.

В заключение заметим, что кинетический механизм образования ячеистых дислокационных структур (процесс пространственной самоорганизации дислокаций) хорошо согласуется с опытом и позволяет объяснить многие связанные с ними закономерности.

Список литературы

- [1] Prinz F., Argon A. S. // Phys. St. Sol. (a), 1980. V. 57. N 2. P. 741—753.
- [2] Youn. C. T., Headley T. J., Lytton J. L. // Mater. Sci. Eng. 1986. V. 81. N 1/2. P. 391—401.
- [3] Tabata T., Imanaka S., Fujita H. // Acta Met. 1978. V. 26. N 3. P. 405—414.
- [4] Конева Н. А., Лычагин Д. В., Жуковский С. П., Козлов Э. В. // ФММ. 1985. Т. 60. № 1. С. 171—179.
- [5] Малыгин Г. А. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 1. С. 175—180.
- [6] Владимирова Г. В., Малыгин Г. А., Рывкина Д. Г. // ФММ. 1989. Т. 67. № 2. С. 380—388.
- [7] Малыгин Г. А. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 7. С. 2057—2072.
- [8] Малыгин Г. А. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 10. С. 3174—3177.
- [9] Кристиан Дж. Теория превращений в металлах и сплавах. М.: Мир. 1978. 806 с.

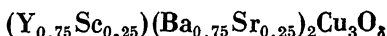
Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
5 января 1989 г.
В окончательной редакции
11 мая 1989 г.

УДК 535.375.5

Физика твердого тела, том 31, в. 9, 1989
Solid State Physics, vol. 31, N 9, 1989

110-ГРАДУСНЫЙ ТЕТРАГОНАЛЬНЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК



А. А. Буш, И. С. Дубенко, М. Ф. Лимонов, Ю. Ф. Марков,
А. Г. Панфилов, Б. С. Разбирин, О. В. Соколова

При анализе путей повышения критической температуры T_c перехода в сверхпроводящее (СП) состояние были сформулированы эмпирические правила Маттиаса: T_c растет с уменьшением массы атома, входящего в сверхпроводящее соединение (в частном случае — изотопический эффект) и с увеличением его радиуса [1]. Заметим, что оба этих атомных параметра определяют частоты колебаний кристаллической решетки. Это обстоятельство предлагается использовать для универсальной оценки ожидаемых изменений T_c в новых СП-системах по колебательным спектрам. Другой закономерностью повышения T_c можно считать ее связь с неустойчивостью кристаллической решетки, отмеченную при исследовании систем типа Nb_3Sn [1, 2].

Одним из возможных путей увеличения T_c для высокотемпературных сверхпроводников является поиск смешанных соединений с неполными изовалентными замещениями, стабилизирующими кристаллическую решетку по возможности близко к концентрационной точке структурной неустойчивости. Поэтому перспективными представляются следующие ряды изовалентных замещений в исходной системе $La-Ba-Cu-O$, приводящие к последовательному уменьшению массы атомов: $La \rightarrow Y \rightarrow Sc$, $Ba \rightarrow Sr \rightarrow Ca$. В результате таких замен из-за существенного различия радиусов замещаемых атомов система может распадаться на ряд несмешивающихся фаз, поэтому для стабилизации решетки следует проводить двоякую параллельную замену, например, типа $(Y_{1-x}Sc_x)(Ba_{1-y}Sr_y)_2Cu_3O_8$.

Ряд образцов $(Y_{1-x}Sc_x)(Ba_{1-y}Sr_y)_2Cu_3O_8$ был приготовлен по обычной керамической технологии, в качестве шихты использовались гомогенизированные смеси оксидов и карбонатов высокой степени чистоты. Рентгено-